

Title (en)
DEMULTIPLEXER COMPRISING A THREE-STATE GATE.

Title (de)
DEMULTIPLEXER MIT TRI-STATE-GATTERANORDNUNG.

Title (fr)
DEMULTIPLEXEUR COMPRENANT UNE PORTE A TROIS ETATS.

Publication
EP 0525168 A1 19930203 (FR)

Application
EP 92906547 A 19920211

Priority
• FR 9200116 W 19920211
• US 65549891 A 19910214

Abstract (en)
[origin: WO9215085A1] A demultiplexer (25) comprises a plurality of transistors (33, 38) with conducting links between an input terminal (31) and output nodes (32). The control electrode of each transistor (33) is connected to a line of a most significant bit (MSB) bus (34) by a first capacitive device and also to a line of a least significant bit (LSB) bus (35) by a second capacitive device. When the capacitive devices associated with the same transistor receive an activation signal at the same time, the transistor (33) turns on and the current flows from the input terminal (31) to an output node (32). Each transistor in the demultiplexer (25) thus acts as a three-state gate.

Abstract (fr)
Démultiplexeur (25) comprenant une pluralité de transistors (33, 38) avec des liaisons conductrices connectées entre une borne d'entrée (31) et des noeuds de sortie (32). L'électrode de commande de chaque transistor (33) est connectée à une ligne d'un bus à bits de poids fort (34) par un premier dispositif capacitif, l'électrode de commande de chaque transistor est aussi couplée à une ligne d'un bus à bits de poids faible (35) par un second dispositif capacitif. Quand les dispositifs capacitifs associés avec le même transistor reçoivent simultanément un signal d'activation, le transistor (33) devient passant et le courant passe de la borne d'entrée (31) à un noeud de sortie (32). Chaque transistor dans le démultiplexeur (25) agit ainsi comme une porte à trois états.

IPC 1-7
G09G 3/36; H03K 17/62; H03K 17/693

IPC 8 full level
G09G 3/20 (2006.01); **G09G 3/36** (2006.01); **H03K 17/693** (2006.01); **H03M 7/22** (2006.01)

CPC (source: EP US)
G09G 3/2011 (2013.01 - EP US); **G09G 3/3688** (2013.01 - EP US); **G09G 2310/027** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 9215085A1

Designated contracting state (EPC)
DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)
WO 9215085 A1 19920903; DE 69219525 D1 19970612; DE 69219525 T2 19970911; EP 0525168 A1 19930203; EP 0525168 B1 19970507; JP 2899681 B2 19990602; JP H05506347 A 19930916; US 5175446 A 19921229

DOCDB simple family (application)
FR 9200116 W 19920211; DE 69219525 T 19920211; EP 92906547 A 19920211; JP 50601092 A 19920211; US 65549891 A 19910214